

15. 結晶工学

イオン注入で生じる欠陥の低減に有効である高温注入や、化合物半導体の注入工程に活用出来る高エネルギーでのイオン注入、活性化アニール処理やその際に必要な保護膜（キャップ膜形成）の形成を行う事が出来ます。

高温イオン注入

最大600℃の高温イオン注入

6inchウエハから、小片試料にも対応

SiC、GaN等への注入ダメージ軽減に有効



高エネルギーイオン注入

最大8MeVまでの注入が可能

6inchウエハから小片試料にも対応

化合物半導体へのイオン注入に必要なAl、P、N、C、Bの注入が可能



活性化アニール

最大1800℃のアニール処理

6inchサイズから小片試料にも対応

熱処理前の保護膜形成ニーズにもお応えいたします

